

SiC メーカー**台湾 Hestia Power Inc.社(瀚薪科技股份有限公司)と
代理店契約締結**

このたび、ダイトエレクトロン株式会社は、次世代半導体である SiC(シリコンカーバイド)を取り扱う Hestia Power 社(本社:台湾 新竹)と代理店契約を締結致しました。

SiC は既存の Si(シリコン)デバイスに対して、大電力化・高信頼性が実現可能な次世代の半導体素子として、市場でも注目を浴びているパワーデバイスです。

Hestia Power 社はワイドバンドギャップ半導体の SiC を使ったショットキーバリアダイオードをラインナップしており、650V 耐圧では 100A、1200V 耐圧では 60A まで各種パッケージ・ベアダイでの提供が可能となります。また、1700V 以上の耐圧に関しても、今後ラインナップを拡張する計画を持っております。

MOSFET に関しても、サンプル提供が開始しており、順次量産を開始する予定です。また、今後の計画として Hestia Power 社が特許を保有している SiC MOSFET と SiC ショットキーバリアダイオードをワンチップ化した JMOS のリリースを控えております。

= Hestia Power 社について =

社名 : Hestia Power Inc. [瀚薪科技股份有限公司]
設立 : 2013 年 4 月
本社所在地 : 台湾 新竹

= 製品ラインナップ =

SiC ショットキーバリアダイオード : 600V, 650V, 1200V, 1700V / ~100A
SiC MOSFET : 650V, 1200V / ~100A

= お問い合わせ先 =

製品担当部門 :ダイトエレクトロン株式会社 電子デバイス営業部
住所 :東京都千代田区麹町 3-6 (住友不動産麹町ビル 3 号館)
電話 :03-3237-1471
e-mail :semicon-info@daitron.co.jp